

2N6714 2N6715 NPN
2N6726 2N6727 PNP

**COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS**



TO-237 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N6714, 2N6726 series types are complementary silicon plastic power transistors designed for general purpose power amplifier and switching applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Continuous Base Current
Power Dissipation
Power Dissipation ($T_C=25^\circ\text{C}$)
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance
Thermal Resistance

SYMBOL	2N6714	2N6715	UNITS
	2N6726	2N6727	
V_{CBO}	40	50	V
V_{CEO}	30	40	V
V_{EBO}		5.0	V
I_C		2.0	A
I_B		0.5	A
P_D		1.0	W
P_D		2.0	W
T_J, T_{stg}		-65 to +150	$^\circ\text{C}$
θ_{JA}		125	$^\circ\text{C/W}$
θ_{JC}		62.5	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

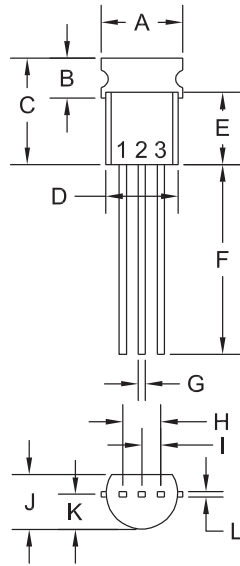
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=\text{Rated } V_{CBO}$		0.1	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$		0.1	μA
BV_{CBO}	$I_C=1.0\text{mA}$, (2N6714, 2N6726)	40		V
BV_{CBO}	$I_C=1.0\text{mA}$, (2N6715, 2N6727)	50		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$, (2N6714, 2N6726)	30		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$, (2N6715, 2N6727)	40		V
BV_{EBO}	$I_E=1.0\text{mA}$	5.0		V
$V_{CE(\text{SAT})}$	$I_C=1.0\text{A}$, $I_B=0.1\text{A}$		0.5	V
$V_{BE(\text{ON})}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=1.0\text{A}$		1.2	V
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=0.1\text{A}$	60		
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=1.0\text{A}$	50	250	
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$, $f=20\text{MHz}$	50	500	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{MHz}$		30	pF

2N6714 2N6715 NPN
 2N6726 2N6727 PNP

COMPLEMENTARY SILICON
 POWER TRANSISTORS



TO-237 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R1

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.160	0.215	4.06	5.46
B	0.095	0.105	2.41	2.67
C	0.260	0.280	6.60	7.11
D (DIA)	0.175	0.205	4.45	5.21
E	0.170	0.210	4.32	5.33
F	0.500	-	12.70	-
G	0.016	0.022	0.41	0.56
H	0.100		2.54	
I	0.050		1.27	
J	0.125	0.165	3.18	4.19
K	0.080	0.105	2.03	2.67
L	0.014	0.016	0.36	0.41

TO-237 (REV: R1)

LEAD CODE:

- 1) Emitter
- 2) Base
- 3) Collector

MARKING: FULL PART NUMBER

R1 (31-July 2012)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.